

УДК 538.115; 538.22

©1994

## РЕЛАКСАЦИОННАЯ МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ В БАЗИСНОЙ ПЛОСКОСТИ КРИСТАЛЛОВ $\text{FeBO}_3$

B. V. Руденко

Проведено теоретическое рассмотрение примесной магнитной анизотропии в кристаллах  $\text{FeBO}_3$ , возникающей при введении дефектных комплексов: вакансия группы  $\text{BO}_3^{3-}$ —3 иона  $\text{Fe}^{2+}$ . Расчет показывает существование одноосной анизотропии релаксационного характера в базисной плоскости кристаллов  $\text{FeBO}_3$ . Объяснен подъем и предсказан спад кривой поля гексагональной анизотропии релаксационного характера (от температуры  $T$ ) при конечных временах ее измерения и стремлении температуры  $T$  к нулю. Показано, что при переходе через точку компенсации константы гексагональной анизотропии эффективная ось кристаллического поля оказывается повернутой на угол  $15^\circ$ .

В работе [1] методом акустического резонанса наблюдалась светоиндуцированная одноосная магнитная анизотропия в (111) плоскости кристаллов  $\text{FeBO}_3$ . Для объяснения в [1] предложена модель, основанная на дефектном комплексе кислородная вакансия–ион  $\text{Fe}^{2+}$ .

В работе [2] одноосная анизотропия в базисной плоскости  $\text{FeBO}_3$  наблюдалась методом антиферромагнитного резонанса (АФМР) без освещения образцов. В области низких температур была обнаружена аномалия гексагональной анизотропии [2,3], причем константа менялась от кристалла к кристаллу.

Точечная группа симметрии идеального кристалла бората железа  $D_{3d}$ , и поэтому в базисной плоскости нет выделенной оси второго порядка. В связи с этим для объяснения наличия одноосной анизотропии в базисной плоскости кристаллов  $\text{FeBO}_3$  необходимо введение в рассмотрение дефектов, понижающих точечную локальную симметрию ионов железа. Кроме того, в [4] был рассчитан вклад ионов  $\text{Fe}^{3+}$  в гексагональную анизотропию. На основе этого расчета и экспериментов [2,3] был сделан вывод о примесной природе низкотемпературной аномалии гексагональной анизотропии в  $\text{FeBO}_3$ .

Эти данные дают основания для рассмотрения модели включающей в себя, с одной стороны примесные центры, а с другой — дефекты, достаточно понижающие точечную локальную симметрию ионов железа.

В [5] сделана попытка теоретического описания этих явлений и выдвинуто предположение о релаксационном характере одноосной и низкотемпературной аномалии гексагональной анизотропии в  $\text{FeBO}_3$ . В работе были рассмотрены модели: 1) анизотропный центр с дефектом по кислороду и 2) анизотропный центр с дефектом по кислороду и железу.

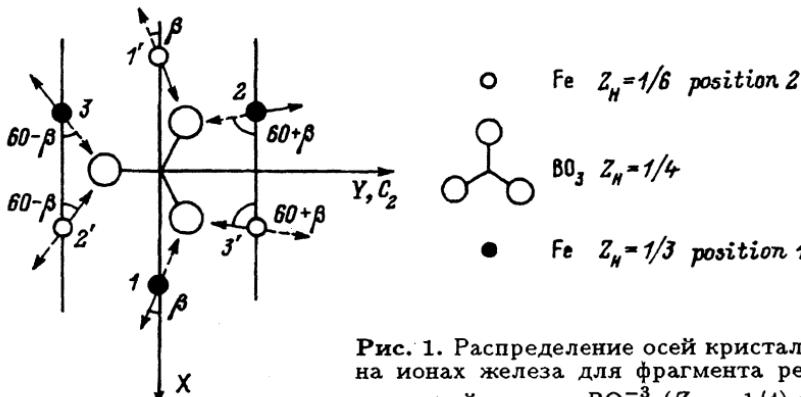


Рис. 1. Распределение осей кристаллического поля на ионах железа для фрагмента решетки  $\text{FeBO}_3$  с вакансией группы  $\text{BO}_3^{-3}$  ( $Z_H = 1/4$ ) в центре.

Однако, несмотря на имеющиеся попытки расчетов, существующие экспериментальные результаты [2] до сих пор не нашли даже качественного описания. Модель фотоиндуцированной анизотропии в кристаллах  $\text{FeBO}_3$  описана в работе [6].

В настоящей работе проведено теоретическое рассмотрение релаксационной магнитной анизотропии в базисной плоскости кристаллов  $\text{FeBO}_3$ , основанное на модели: вакансия группы  $\text{BO}_3^{-3}$ -3 иона  $\text{Fe}^{2+}$ ; концентрация вакансий  $\text{BO}_3^{-3}$   $c_0 \ll 1$ . Использование такой модели имеет под собой основание. С одной стороны, группа  $\text{BO}_3^{-3}$  является энергетически сильно связанный, поэтому, вероятно, она может встраиваться в решетку растущего кристалла в виде единого целого или создавать такую вакансию. С другой стороны, введением трех ионов  $\text{Fe}^{2+}$  достигается электронейтральность кристалла в целом. Наличие в борат-свинцовом растворителе групп  $\text{BO}_3^{-3}$  подтверждается данными, приведенными в [7]. Такая модель предложена в [8].

На рис. 1 показано распределение осей кристаллического поля на ионах железа, возникающего за счет вакансии  $\text{BO}_3^{-3}$ . Здесь же приведены значения, указывающие  $Z_H$  координату в гексагональной установке для группы  $\text{BO}_3^{-3}$  и ионов Fe. Ниже ( $Z_H = 0$ ) и выше ( $Z_H = 1/2$ ) этой группы находятся ионы  $\text{Fe}^{2+}$  (ионы типа A), они не показаны на рисунке. Один из ионов железа ( $Z_H = 1/3$  или  $1/6$ ), расположенных вокруг вакансии  $\text{BO}_3^{-3}$  в проекции на плоскость чертежа (ионы типа B), имеет валентность  $2^+$ , тогда как остальные  $3^+$ . При наложении определенных внешних воздействий будет наблюдаться движение электрона по позициям ионов железа типа B вокруг вакансии  $\text{BO}_3^{-3}$ . Сплошные стрелки имеют положительную, штриховые — отрицательную компоненты на ось Z. Ось Z выходит из плоскости чертежа. Через  $\pm\beta$ ,  $60 \pm \beta$  обозначены углы между проекциями осей на плоскости чертежа и сплошными линиями, параллельными X. Ось X лежит в плоскости симметрии кристалла.

Распределение осей кристаллического поля на ионах железа для фрагмента кристаллической решетки, в центре которой расположена вакансия верхней группы  $\text{BO}_3^{-3}$  ( $Z_H = 3/4$ ), приведено на рис. 2. Нижняя ( $Z_H = 1/4$ ; рис. 1) и верхняя ( $Z_H = 3/4$ ; рис. 2) группы различаются

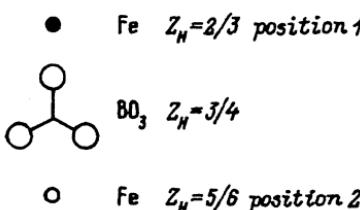
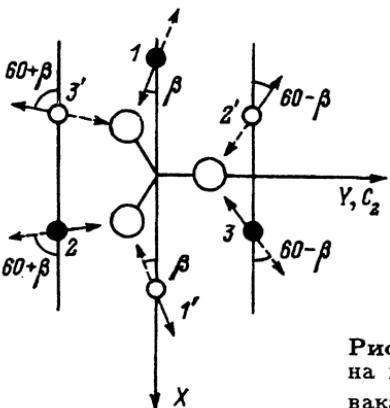


Рис. 2. Распределение осей кристаллического поля на ионах железа для фрагмента решетки  $\text{FeBO}_3$  с вакансиею группы  $\text{BO}_3^{-3}$  ( $Z_H = 3/4$ ) в центре.

ориентацией в плоскости чертежа. Такое распределение осей следует из рассмотрения локальной симметрии ионов железа в кристаллических комплексах.

Будем учитывать в дефектной конфигурации магнитную анизотропию ионов  $\text{Fe}^{2+}$ , пренебрегая  $\text{Fe}^{3+}$ . Предполагается, что в позициях 1 и 2 моменты упорядочены антиферромагнитно. Точечная локальная симметрия позиций ионов  $\text{Fe}^{2+}$  типа  $B$  есть  $C_1$ , и поэтому анизотропия будет описываться тензором триклиновой сингонии. Энергия анизотропии, приходящаяся на один ион  $\text{Fe}^{2+}$  кристалла

$$E_{\alpha_k} = \sum_{ij} B_{\alpha_k ij} M_{ki} M_{kj},$$

где  $k$  может приобретать значения от 1 до 12 для всех ионов железа типа  $B$ , окружающих вакансию  $\text{BO}_3^{-3}$  на рис. 1, 2:  $\alpha_k$  — угол, на который повернута проекция оси кристаллического поля на плоскость (111) от оси  $X$  для  $k$  иона (все  $\alpha_k$  показаны на рисунках);  $i, j = X', Y', Z'$ ,  $M_k$  — подрешеточный магнитный момент  $k$  иона  $\text{Fe}^{2+}$ ;  $B_{\alpha_k ij}$  — тензор анизотропии триклиновой симметрии в системе координат  $X', Y', Z'$  ( $Z' = Z$ ,  $X'$  совпадает с проекцией оси кристаллического поля на плоскость чертежа соответствующего иона  $\text{Fe}^{2+}$ ). Вращая систему координат  $X'Y'Z'$  вокруг  $Z'$  на углы, указанные на рис. 1, 2, так, чтобы  $X'$  совместилась с осью  $X$ , и учитывая, что тензор  $B_{\alpha_k ij}$  обладает центром симметрии, для  $k$  иона  $\text{Fe}^{2+}$  получим

$$\begin{aligned}
 E_{\alpha_1} = & \frac{1}{2} (B_{11} + B_{22}) + \left( B_{33} - \frac{1}{2} (B_{11} + B_{22}) \right) \cos^2 \theta'_1 + \\
 & + \frac{1}{2} (B_{11} - B_{22}) \cos 2(\varphi'_1 + \alpha + \beta) \sin^2 \theta'_1 + B_{12} \sin 2(\varphi'_1 + \alpha + \beta) \sin^2 \theta'_1 + \\
 & + B_{13} \cos (\varphi'_1 + \alpha + \beta) \sin 2\theta'_1 + B_{23} \sin (\varphi'_1 + \alpha + \beta) \sin 2\theta'_1
 \end{aligned} \quad (1)$$

для первой позиции,

$$E_{\alpha_2} = \frac{1}{2} (B_{11} + B_{22}) + \left( B_{33} - \frac{1}{2} (B_{11} + B_{22}) \right) \cos^2 \theta'_2 + \\ + \frac{1}{2} (B_{11} - B_{22}) \cos 2(\varphi'_2 + \alpha - \beta) \sin^2 \theta'_2 + B_{12} \sin 2(\varphi'_2 + \alpha - \beta) \sin^2 \theta'_2 + \\ + B_{13} \cos(\varphi'_2 + \alpha + \beta) \sin 2\theta'_2 + B_{23} \sin(\varphi'_2 + \alpha - \beta) \sin 2\theta'_2 \quad (2)$$

для иона  $\text{Fe}^{2+}$  во второй позиции. Здесь  $\alpha_1 = \alpha + \beta$ ;  $\alpha_2 = \alpha - \beta$ ;  $\alpha$  принимает значения  $0, \pm 60^\circ$ ;  $\theta'_1, \theta'_2$  и  $\varphi'_1, \varphi'_2$  — полярный и азимутальный углы для подрешеточного магнитного момента в первой и второй позициях соответственно для компонент тензора анизотропии  $X \rightarrow 1$ ,  $Y \rightarrow 2$ ,  $Z \rightarrow 3$ . Будем предполагать, что магнитные моменты ионов  $\text{Fe}^{2+}$  в комплексах на рис. 1, 2 расположены антиферромагнитно.

Суммируя выражения (1), (2) и вводя углы  $\theta'$  и  $\varphi'$ , для вектора антиферромагнетизма  $\mathbf{l}' (\theta'_1 = \theta', \varphi'_1 = \varphi', \theta'_2 = \pi - \theta', \varphi'_2 = \varphi' + \pi)$  получим

$$E_\alpha = \frac{1}{2} (B_{11} + B_{22}) + \left( B_{33} - \frac{1}{2} (B_{11} - B_{22}) \right) \cos^2 \theta' + \\ + \frac{1}{2} (B_{11} - B_{22}) \cos 2\beta \cos 2(\varphi' + \alpha) \sin^2 \theta' + B_{12} \cos 2\beta \sin 2(\varphi' + \alpha) \sin^2 \theta' + \\ + B_{13} \cos \beta \cos(\varphi' + \alpha) \sin 2\theta' + B_{23} \cos \beta \sin(\varphi' + \alpha) \sin 2\theta'. \quad (3)$$

Движения электрона по ионам железа типа  $A$  не происходит. Точечная локальная симметрия позиций этих ионов  $C_{3i}$ , поэтому для вектора антиферромагнетизма добавятся анизотропные члены

$$E' = B_{33} \cos^2 \theta' + q'' \sin^3 \theta' \cos \theta' \cos 3\varphi'.$$

Энергия примесной анизотропии на моль вещества кристалла  $\text{FeBO}_3$  может быть представлена в виде

$$E = 2Nc_0 B_{33} \cos^2 \theta' + 2Nc_0 q'' \sin^3 \theta' \cos \theta' \cos 3\varphi' + Nc_0 \sum_\alpha c_\alpha E_\alpha. \quad (4)$$

Здесь  $c_0 = V_0 N' / VN$ , где  $V_0$  — объем моля  $\text{FeBO}_3$ ,  $V$  — объем кристалла,  $N$  — число Авогадро,  $N'$  — число вакансий  $\text{BO}_3^{-3}$  в кристалле,  $c_\alpha$  — относительная концентрация ионов  $\text{Fe}^{2+}$  в  $\alpha$  направлении,  $\sum c_\alpha = 1$ .

Обозначим ионы железа, лежащие в неэквивалентных направлениях в кристалле  $\alpha = 0, -60, 60^\circ$ , как 1, 2, 3 для первой подрешетки и  $1', 2', 3'$  — для второй и найдем  $c_\alpha$  из кинетических уравнений аналогично [9]. Будем рассматривать только «перескоки» электрона между ближайшими ионами  $1-3'-2-1'-3-2'-1$ . При этом «перескоки» электронов скоррелированы одновременным движением из позиций 1 в 2 и из 2 в 1 в эквивалентных направлениях (например, от иона 1 к  $2'$  и от  $1'$  к 2; рис. 1, 2) «перескоки» электронов  $1-2-3, 1'-2'-3'$  учитывать не будем, так как предполагается, что вероятность их мала (расстояние типа  $1-2' 3.6 \text{ \AA}$ , типа  $1-2 4.6 \text{ \AA}$ ).

Потенциальный барьер, преодолеваемый электроном при «перескоках», обозначим  $E_b$ , а энергию анизотропии для каждого направления в решетке кристалла —  $E_n$  ( $n = 1, 2, 3$ ; здесь  $\alpha \rightarrow n$ ). Тогда скорость

изменения концентрации  $\text{Fe}^{2+}$ , например, в направлении 1 будет пропорциональна частоте «перескока» электрона, Больцмановскому фактору и  $c_n$  в соответствующих позициях

$$c_1 = \nu_0 c_2 \exp\left(-\frac{E_b - E_2}{kT}\right) + \nu_0 c_3 \exp\left(-\frac{E_b - E_3}{kT}\right) - 2\nu_0 c_1 \exp\left(-\frac{E_b - E_1}{kT}\right),$$

здесь  $\nu_0$  — частота перескока электрона между позициями для  $kT \gg |E_b - E_n|$ .

Полная система уравнений будет иметь вид

$$\begin{pmatrix} \dot{c}_1 \\ \dot{c}_2 \\ \dot{c}_3 \end{pmatrix} = \nu \begin{pmatrix} -2 \exp(E_1/kT) & \exp(E_2/kT) & \exp(E_3/kT) \\ \exp(E_1/kT) & -2 \exp(E_2/kT) & \exp(E_3/kT) \\ \exp(E_1/kT) & \exp(E_2/kT) & -2 \exp(E_3/kT) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

здесь  $\nu = \nu_0 \exp(-E_b/kT)$ .

Решение системы уравнений (5), проведенное по стандартной методике [10], дает

$$c_1 = B_1 + B_2 \exp(p\nu t) + B_3 \exp(r\nu t),$$

$$c_2 = \frac{A_1 B_1}{A_2} + \frac{3A_1 + p}{3A_2 + p} B_2 \exp(p\nu t) + \frac{3A_1 + r}{3A_2 + r} B_3 \exp(r\nu t),$$

$$c_3 = \frac{A_1 B_1}{A_3} + \frac{3A_1 + p}{3A_3 + p} B_2 \exp(p\nu t) + \frac{3A_1 + r}{3A_3 + r} B_3 \exp(r\nu t),$$

где

$$A_n = \exp(E_n/kT),$$

$$p = -(A_1 + A_2 + A_3) + \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 - (A_1 A_2 + A_1 A_3 + A_2 A_3)},$$

$$r = -(A_1 + A_2 + A_3) - \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 - (A_1 A_2 + A_1 A_3 + A_2 A_3)},$$

$B_1, B_2, B_3$  — константы, определяемые из предельных условий;  $t$  — параметр времени.

Разлагая  $p$  и  $r$  в ряд по  $E_n/kT$ , получим  $p = r \approx -3$ , и найдя выражение для  $B_1, B_2, B_3$ , имеем

$$c_n(\varphi', \varphi'_0, t) = c_n^0(\varphi') + [c_n^0(\varphi'_0) - c_n^0(\varphi')] \exp(-3\nu t).$$

Здесь  $\varphi'$  — угол, на который повернут примесный вектор антиферромагнетизма  $\mathbf{l}'$  при произвольной температуре;  $\varphi'_0$  — угол («отжига» образца), на который повернут  $\mathbf{l}'$  при температуре, когда свободно проходит перераспределение электронов по позициям;  $c_n^0 = A_n^{-1}/\sum A_n^{-1}$ . Момент времени  $t = 0$  является границей между состоянием системы, когда существует равновесное распределение дефектов, соответствующее повороту  $\mathbf{l}'$  на  $\varphi'_0$ , и когда  $\mathbf{l}'$  повернут на угол при произвольной температуре.

Разложим экспоненты в ряд по  $E_n/kT$  в выражениях для  $c_n^0$  и про суммируем в (4) по  $\alpha$ . Тогда

$$E = \frac{1}{2}a' \cos^2 \theta' - D \sin^3 \theta' \cos \theta' \cos(3\varphi' - \psi) + q' \sin^3 \theta' \cos \theta' \cos 3\varphi' + \\ + \left\{ D \sin^3 \theta' \cos \theta' \cos(3\varphi' - \psi) - G \sin^2 \theta' \sin^2 \theta'_0 \cos 2(\varphi' - \varphi'_0) - \right. \\ \left. - \frac{1}{2}D \left[ \sin^2 \theta' \sin \theta'_0 \cos \theta'_0 \cos(2\varphi' + \varphi'_0 - \psi) + \sin^2 \theta'_0 \cos \theta' \cos(\varphi' + 2\varphi'_0 - \psi) \right] - \right. \\ \left. - L \sin \theta' \cos \theta' \sin \theta'_0 \cos \theta'_0 \cos(\varphi' - \varphi'_0) \right\} \exp(-3\varphi v t).$$

Здесь введены обозначения

$$a' = 2Nc_0 \left( 3B_{33} - \frac{1}{2}(B_{11} + B_{22}) \right),$$

$$D = \frac{Nc_0 \cos \beta \cos 2\beta}{kT} \times$$

$$\times \sqrt{\left[ (B_{11} - B_{22}) B_{13} - 2B_{12} B_{23} \right]^2 + \left[ (B_{11} - B_{22}) B_{23} + 2B_{12} B_{13} \right]^2},$$

$$G = \frac{Nc_0 \cos^2 2\beta}{8kT} \left[ (B_{11} - B_{22})^2 + 4B_{12}^2 \right], \quad L = \frac{2Nc_0 \cos^2 \beta}{kT} (B_{13}^2 + B_{23}^2),$$

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{(B_{11} - B_{22}) B_{23} + 2B_{12} B_{13}}{(B_{11} - B_{22}) B_{13} - 2B_{12} B_{23}}, \quad q' = 2Nc_0 q'',$$

$\theta'_0$  — полярный угол для  $\mathbf{l}'$  при температуре, когда перераспределение электронов идет свободно.

Запишем функцию  $\Phi$ , представляющую собой сумму термодинамического потенциала идеального кристалла, энергии анизотропии  $E$  и обмена

$$\Phi = \frac{1}{2}Bm^2 + \frac{1}{2}al_z^2 + d(l_x m_y - l_y m_x) + q(l_x^3 - 3l_x l_y^2)l_z - mh + All' + E. \quad (6)$$

Здесь опущен инвариант шестой степени для гексагональной анизотропии, поскольку в  $\text{FeBO}_3$  он не дает вклада [2,4]. Членами, связанными взаимодействием примеси с внешним магнитным полем, пренебрегается из-за низкой концентрации дефектов  $c_0$ . Пренебрегается также членами вида  $ml'$ ,  $m'l$ ,  $mm'$  по сравнению с  $ll'$ .

Положение вектора  $\mathbf{l}'$  в плоскости (111) будет определяться конкуренцией базисной анизотропии и обмена  $All'$ . Пренебрегая в (6) базисной анизотропией, найдем, что в плоскости (111)  $\mathbf{l}$  и  $\mathbf{l}'$  коллинеарны. Будем предполагать, что угол  $\theta'$  близок к  $90^\circ$ . В пользу такого предположения свидетельствует небольшое абсолютное значение величины гексагональной анизотропии  $\text{FeBO}_3$  при низких температурах [2,3] по сравнению с одноосной. В дальнейшем будем полагать  $\theta' = \theta$ , так как для описания магнитной анизотропии является несущественным небольшая разориентация  $\mathbf{l}$  и  $\mathbf{l}'$ . Это предположение значительно упрощает дальнейшее рассмотрение. Тогда (6) примет вид

$$\Phi = \frac{1}{2}Bm^2 + \frac{1}{2}(a + a') \cos^2 \theta + d \sin \theta (m_y \cos \varphi - m_x \sin \varphi) +$$

$$\begin{aligned}
& + (q + q') \sin^3 \theta \cos \theta \cos 3\varphi - m h - D \sin^3 \theta \cos \theta \cos(3\varphi - \psi) + \\
& + e^{-3\nu t} \left\{ D \sin^3 \theta \cos \theta (3\varphi - \psi) - G \sin 2\theta \sin^2 \theta_0 \cos 2(\varphi - \varphi_0) - \right. \\
& \left. - \frac{1}{2} D \left[ \sin^2 \theta \sin \theta_0 \cos \theta_0 \cos(2\varphi + \varphi_0 - \psi) + \sin \theta \cos \theta \sin^2 \theta_0 \cos(\varphi + 2\varphi_0 - \psi) \right] \right\}. \tag{7}
\end{aligned}$$

Здесь константа  $B$  перенормирована,  $\cos \theta \cos \theta_0 \approx 0$  в выражениях для базисной анизотропии.

Из (7) следует, что существуют два типа анизотропии релаксационного характера в базисной плоскости кристаллов FeBO<sub>3</sub>. Первый тип — это одноосная анизотропия, которая может быть создана, например, в результате «отжига» образца с последующим наложением внешнего воздействия, упорядочивающего Fe<sup>2+</sup> в одном направлении, и затем его, хотя бы частичного, «замораживания». Второй тип — это гексагональная анизотропия, которая возникает только в результате перераспределения Fe<sup>2+</sup> по позициям в трех направлениях. В обоих случаях, появившиеся добавочные кристаллические электрические поля за счет упорядочения пар вакансия BO<sub>3</sub><sup>-3</sup>-ион Fe<sup>2+</sup> могут служить причиной одноосной и гексагональной анизотропии релаксационного характера. Отметим, что ростовые дефекты распределены статистически по кристаллу, при этом симметрия его макроскопических свойств остается  $D_{3d}$ . Однако как только мы накладываем внешнее воздействие, например магнитное поле, в одном направлении происходит упорядочение пар группы BO<sub>3</sub><sup>-3</sup>-ион Fe<sup>2+</sup> и симметрия макроскопических свойств кристалла как единого целого понижается. Вместе с тем макроскопические свойства основного объема имеют симметрию точечной группы идеального кристалла  $D_{3d}$ . Таким образом, в небольшой части кристалла, имеющего более низкую симметрию макроскопических свойств, будет существовать одноосная анизотропия релаксационного характера. Вращение внешнего магнитного поля в базисной плоскости кристалла, упорядочивающее примеси, имеет симметрию круга. Она будет понижаться до  $D_{3d}$  точечной симметрией кристалла, и в результате перераспределения примесей мы получим добавочную гексагональную анизотропию релаксационного характера. Реальная же картина оказывается более сложной. В базисной плоскости кристалла при определенных условиях присутствует и одноосная, и гексагональная анизотропия.

Из (7) также видно, что гексагональная анизотропия релаксационного характера появляется при  $t > 0$ , т.е. при движении системы к равновесию. В момент  $t = 0$  она отсутствует. При  $T \rightarrow 0$  (но когда еще справедливо разложение в ряд по степеням  $E_n/kT$ ) и конечных значениях  $t$  подъем релаксационной гексагональной анизотропии должен смениться спадом, так как она будет «замораживаться», и поэтому ее значение стремится к нулю. Эти результаты объясняют экспериментальные данные работы [2,3] в низкотемпературной области.

Для экспериментальной проверки расчетов приведем некоторые выражения и соотношения, полученные для АФМР методики. Запишем резонансную частоту низкочастотной ветви спектра АФМР, используя (7). Рассмотрим частный случай, когда система находится в равновесии ( $t = \infty$ ). Используя (7) и результаты работы [11], находим для

$$\left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^2 = H(H + H_d) + 36H_EH_Q \cos(6\varphi_H + 2\psi_0),$$

где

$$H_d = \frac{d}{M}, \quad H_E = \frac{B}{M}, \quad H_Q = -\frac{1}{M} \frac{Q^2}{4(a + a' + d^2/B)},$$

$M$  — удвоенный подрешеточный магнитный момент в FeBO<sub>3</sub> на моль вещества,  $\varphi_H$  — угол между внешним магнитным полем и осью  $X$ ,

$$Q = \sqrt{\left\{q + q' - \frac{Nc_0 \cos \beta \cos 2\beta}{kT} [(B_{11} - B_{22})B_{13} - 2B_{12}B_{23}]\right\}^2 + \left\{\frac{Nc_0 \cos \beta \cos 2\beta}{kT} [(B_{11} - B_{22})B_{23} + 2B_{12}B_{13}]\right\}^2},$$

$$\operatorname{tg} \psi_0 = \frac{Nc_0 \cos \beta \cos 2\beta [(B_{11} - B_{22})B_{23} + 2B_{12}B_{13}]}{kT(q + q') - Nc_0 \cos \beta \cos 2\beta [(B_{11} - B_{22})B_{13} - 2B_{12}B_{23}]}.$$

В точке компенсации имеем  $H_Q = 0$ , откуда

$$(B_{11} - B_{22})B_{23} + 2B_{12}B_{13} = 0,$$

для  $\operatorname{tg} \psi_0$  возникает неопределенность 0/0, однако фаза  $\psi_0$  медленно возрастает при понижении температуры и первым ее значением, при котором поле гексагональной анизотропии меняет знак, будет  $\psi_0 = 45^\circ$ . Отсюда следует, что при переходе через точку компенсации эффективная ось кристаллического поля оказывается повернутой на угол  $15^\circ$ .

### Список литературы

- [1] Seavey M.H. // Sol. St. Comm. 1973. V. 12. N 1. P. 49–52.
- [2] Руденко В.В. // Автореф. канд. дис. Симферополь, МВССО УССР, 1983.
- [3] Дорошев В.Д., Крыгин И.М., Молчанов А.Н., Прохоров А.Д., Руденко В.В., Селезнев В.Н. // Письма в ЖЭТФ. 1979. Т. 29. № 5. С. 286–290.
- [4] Руденко В.В. // ФТТ. 1980. Т. 22. № 3. С. 775–779.
- [5] Федоров Ю.М. // Препринт ИФСО-122Ф. Красноярск, ИФ СО АН СССР, 1980.
- [6] Звездин А.К., Мухин А.А. // Краткие сообщения по физике. 1988. № 5. С. 20.
- [7] Wanklyn B.M. // J. Cryst. Grow. 1983. V. 65. P. 533–540.
- [8] Петраковский Г.Н., Руденко В.В., Соснин В.М. // Препринт 571Ф. Красноярск, ИФ СО АН СССР, 1989.
- [9] Hunt R.P. // J. Appl. Phys. 1967. V. 38. N 7. P. 2826–2836.
- [10] Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. М.: Наука, 1972.
- [11] Туров Е.А., Гусейнов Н.Г. // ЖЭТФ. 1960. Т. 38. № 4. С. 1326–1331.

Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН  
Красноярск

Поступило в Редакцию  
29 июля 1993 г.

В окончательной редакции  
25 января 1994 г.